偏置电场对聚对苯乙烯激发态弛豫特性的影响*

程 萍 高 峰 陈向东 杨继平[†] (合肥工业大学电子科学与应用物理学院,合肥 230009) (2009年6月7日收到;2009年8月12日收到修改稿)

为探讨洞悉电场对有机发光二极管电致荧光量子效率的影响,通过激发-探测超快光谱技术研究了激子在电场下的瞬态行为.与单重态激子相应的激发态在 230 μJ/cm² 激发强度下,显示了快慢两个弛豫过程.快慢组分的权重因子及快组分弛豫时间常数是电场相关的,在 6.4×10⁵ V/cm 的电场下,与无偏置电场相比,激子的快组分弛 豫时间加速,快组分的权重因子由 22% 增加为 72%,约 50% 的初始激子又通过电场而离解.慢组分是电场无关的, 其弛豫时间常数为 890 ps.实验结果还揭示了由激发光所产生的长程声学声子,其声速为 17 Å/ps.

关键词:聚对苯乙烯,超快光谱,激子,有机发光二极管 PACC:7847,7280L,7280H

1. 引 言

光致或电致激子的产生、离解及重组是基于导 电高分子材料的有机太阳能电池和有机发光二极 管(OLED)中的基本物理过程.OLED 装置只有在 相对低的驱动电压下,才能获得最大的电致荧光量 子产额^[1],这样的限制有可能成为 OLED 在实际应 用中的瓶颈^[2].为了减少电场对电致荧光量子效率 的影响,在电场条件下激子猝灭机制的研究就尤为 重要.最近的研究表明[3],高电场可以引起这类材 料中激发态的离解,这将导致激子的猝灭.因而在 激子猝灭的过程中,激子离解是激子猝灭的主要原 因之一^[3]. 尽管这类光物理过程已借助于稳态^[4]、 瞬态荧光光谱^[5]及理论模拟^[6]进行了研究,但是激 子初始的猝灭时间并没有确定^[7]. 超快激光光谱技 术的发展提供了研究瞬态光物理过程新的手段[8], 而通过与电场相联系的时间分辨的瞬态吸收光谱 可以使我们更好地比较在有无电场时激子的衰减 过程,从而进一步洞悉激子猝灭的机制和时间常 数.我们采用典型的导电高分子材料聚对苯乙烯 (PPV)作为样品,借助于时间分辨的瞬态吸收光谱 实验,确定了施加的电场所引起初始激子的快速猝 灭及其弛豫时间常数.我们还观测到了在样品中由 激发光所产生的应变及与其相应的长程声学声子 和超声速.

2. 实验方法

2.1. 样品制备

PPV 样品是从 1,4-苯二亚甲基-二(四硫酰氯) (1,4-phenylene dimethylene-bis (tetramethylen sulfonium chloride))的单聚体开始进行聚合,并产生水溶性的 锍盐电解质(sulfonium salt polyelectrolyte).使用医 生刀片技术(doctor blade technique)将其在镀有铟 锡金属氧化物(indium-tin-oxide, ITO)导电层的石 英片上制成薄膜,随后在真空中 300 ℃的温度下保 持3h,则转换成 PPV 薄膜,其厚度为 140 nm. 在瞬 态光谱实验中,样品被放置在真空恒温器中. 在测 量电场效应时,施加电压为 9 V,则相应的电场为 6.4×10⁵ V/cm. 为了避免电荷注入,采用反向偏 置^[9],即 ITO 为负电极.

2.2. 实验装置

在瞬态的光致感应的吸收实验中,使用锁模的 掺铷钇铝石榴石(Nd:YAG)激光器,脉宽 35 ps,基 波波长 1064 nm,基波的三倍频 355 nm 作为激发光

^{*}国家自然科学基金(批准号:20573030)资助的课题.

[†]通讯联系人. E-mail:yangjp@hfut.edu.cn

脉冲,激发脉冲能量为 30 μJ,在样品上的光斑直径 约4 mm,相应于激发通量为 230 μJ/cm².探测脉冲 是由基波聚焦到重水(D₂O)中,产生皮秒白光,并被 分成探测和参考光束.探测和激发光束都通过真空 恒温器的前石英窗口被聚焦到样品上,探测光束由 后石英窗口出射并与参考光束分别引入 Y-型光纤 入口,再由 Y-型光纤输入光学多道分析仪(OMA). 探测和激发光束之间的时间延迟由时间延迟仪控 制.整个实验由计算机控制.

2.3. 实验数据处理

由 OMA 获得的探测和参考光束光谱,经如下 数学计算后得到光致感应的透射率变化:

$$-\frac{\Delta T}{T}(\lambda, t) = 1 - \frac{T}{T_0}$$
$$= 1 - \left[\frac{I_{\rm T}(\lambda, t)}{I_{\rm R}(\lambda, -\infty)}\right] / \left[\frac{I_{\rm T}(\lambda, -\infty)}{I_{\rm R}(\lambda, -\infty)}\right], \qquad (1)$$

其中 $I_{\rm T}$ 和 $I_{\rm R}$ 分别表示探测和参考光谱.为了提高信 噪比,在每一个时间延迟点,获取 30 个光谱,然后平 均以计算光致感应的透射率变化.当 – $\Delta T/T$ < 0 时,则意味着是消光或者受激荧光,反之,就是光致 感应的吸收.而激发态的弛豫过程则假设激发光是 高斯函数形状的脉冲并由双指数拟合(或单指数):

$$-\frac{\Delta T}{T}(t) = \left(1 + \operatorname{erf}\left(\frac{(2 \times 0.693(t - t_0))}{\tau}\right)\right) \times \left(a \exp\left(-\frac{(t - t_0)}{\tau_1}\right) + b \exp\left(-\frac{(t - t_0)}{\tau_2}\right) + c\right), \quad (2)$$

其中 τ_1 和 τ_2 分别是弛豫时间常数, a和 b是两个弛 豫时间常数的权重.

3. 结果和讨论

激发和探测光是从铝电极这面入射,即 Al/ PPV/ITO.图1表明了在无偏置电场时瞬态吸收最 大值时的光致感应的瞬态吸收谱.实验研究表明, 施加偏置电场对瞬态吸收谱轮廓没有本质上的改 变.图1中的插图则是 PPV 的静态吸收光谱.与吸 收光谱相比较,我们可以确定在瞬态吸收光谱中的 负值部分是光致感应的消光.消光部分有两个明显 的振动结构,分别在 463 和 496 nm,这两个振动结 构的能量差约是 0.18 eV,这是 C == C 伸缩振动模. 而瞬态吸收有着一个宽的光谱范围,从 524 到 900 nm.吸收中心位于约 810 nm 处,在 810 nm 这个波 长范围只有光致感应的吸收,没有受激荧光.由于 在基态非简并的导电高分子材料中初始的光致感 应的元激发是激子^[10],因而我们把此吸收归于激子 的吸收.在 543 nm 处也有一吸收峰,但是在此波长 范围,受激荧光,光致感应的吸收和消光都交叠在 一起,导致了在此波长随时间延迟的光致感应透射 率的变化有着大的起伏(未用图表示).而在 600 nm 附近有一低谷,这也是两个光物理过程光致感应 的吸收和受激荧光竞争的结果.



图 1 瞬态吸收谱图 (在 355 nm 激光脉冲激发下在"时间零 点" PPV 的光致感应瞬态吸收谱),内插图是 PPV 的稳态吸收谱

如上所述,施加偏置电场对瞬态吸收谱轮廓没 有本质上的改变,为了观测电场效应对光致感应吸 收动态过程的影响,我们通过在各个时间延迟点测 取的瞬态吸收谱,获得了在吸收峰值810 nm 处与延 迟时间变化相关的光致感应吸收动态过程,如图2 所示.从实验结果看到,与无电场相比,在施加偏置 电场时,初始的激子弛豫明显加快.

有机导电高分子材料光致激子的超快弛豫过 程通常是非单指数的衰减^[11],并常借助于速率方 程^[11]或多指数^[12]进行数据拟合.研究^[13,14]表明, 有机分子在光激发后的超快弛豫过程又是激发强 度相关的, Shkunov等^[13]报道,在 PPV 的衍生物 DOO-PPV 中快组分是激发强度相关的. 当激发强度 低于 20 μJ/cm² 时,光致感应的吸收只有慢组分. 在 高强度激发下(250 μJ/cm²),光致感应的吸收显示 了快慢组分.黎爱珍等^[14]也报道了聚合物荧光在高 激发密度的情况下,会出现超快猝灭过程.我们的 激发强度(230 µJ/cm²)已远远地大于单组分弛豫 的激发强度阈值 20 µJ/cm²,所以在 PPV 中光致感 应的吸收变化显示了快、慢两个弛豫过程.因而,在 高的激发强度下涉及到激子-激子的相互作用,因此 弛豫过程不再仅仅是一个慢过程.而在数据拟合 时,为了真实地拟合受激分子在光激发后的信号, 应该要考虑到激发脉冲的函数并进行去卷积处 理^[15],正如方程(2)所描述的.我们的数据拟合的 结果表明,双指数的拟合很好地描述了在810 nm 处 的光致感应吸收动态过程,所有拟合结果如表1所 示.从表1中我们可以看到,在测量误差范围内,慢 组分与施加电场无关. Samuel 等^[16]报道,单重态激 子在 PPV 及它的衍生物中的寿命在 200 ps 到 1.2 ns之间,这依赖于样品的氧化程度^[17]和共轭长度的 分布^[15]. Heeger^[18]报道, PPV 的激发态寿命是几百 个皮秒, McBranch 等^[19]确定了 PPV 的荧光寿命为 900 ps. 因而我们可以把时间常数为 860 ps 或 890 ps 的慢组分归于单重态激子的寿命. 快组分表现出 电场相关,从无偏置电场的77 ps 到有偏置电场的 47 ps. Kepler 等^[20]已经证实了在 PPV 等导电高分 子材料中与激发强度相关的激子-激子的湮没,黎爱 珍等[14]也报道了聚合物荧光在高激发密度的情况 下,会出现由激子-激子相互作用所导致的快速猝灭 过程,因而我们把快组分归于光激发后的激子-激子 的湮没过程.施加电场后,又增加了一个激子猝灭 过程,即由电场引起的激子离解^[7,21],这就必然导 致了快组分的加速弛豫.快组分的时间常数也与 Arkhipov等^[7]推测激子初始的猝灭效应时间在 0.5—100 ps之间一致的,因而我们可以把快组分归 于描述初始激子的猝灭过程.另一方面是快慢组分 权重的变化,如表1所示,在无偏置电场时,近80% 的激子由慢组分从激发态弛豫到基态;而在施加电 场时,超过70%的激子在几十个皮秒内猝灭,与无 偏置电场的22%的快组分权重相比较,其中50%的 初始激子是由电场的离解而猝灭,而小部分激子 (28%)仍是由激发态弛豫到基态.



图 2 时间演化动力学曲线 (在 355 nm 激光脉冲激发下在 810 nm 处 PPV 与延迟时间相关的瞬态吸收弛豫)

表1 在有、无偏置场时瞬态弛豫的时间常数和权重

| 探测波长 / nm | 偏置电场/V | 权重1 | $	au_1 / 	ext{ ps}$ | 权重2 | $\tau_2/~{\rm ps}$ | 谐振周期 / ps |
|-----------|--------|------|---------------------|------|--------------------|-------------|
| 810 | 0 | 0.22 | 77 ± 60 | 0.78 | 860 ± 230 | |
| 810 | 9 | 0.72 | 47 ± 18 | 0.28 | 890 ± 500 | |
| 496 | 0 | | | | 890 ± 144 | 331 ± 3 |
| 496 | 9 | | | | 1207 ± 239 | 334 ± 2 |

我们也观测了在消光光谱范围 496 nm 处的弛 豫过程,如图 3 所示,结果显示了量子拍频的谐振结 构.由于谐振的特点,在 810 nm 处观测到的快组分 可能淹没在其中,因而实验数据仅由单指数拟合并 考虑到一个正弦函数的谐振振荡,拟合结果如表 1 所示.在实验误差范围内,其弛豫时间常数是与 810 nm 处获得的慢组分一致的,而一个附加的谐振振荡 周期分别是 331 ps(无偏置电场)和 334 ps(有偏置 电场),考虑到实验误差,谐振振荡周期应与电场无 关. Thomsen 等^[22]已在 α-As₂Te₃ 中观测到类似的现 象,并且在聚噻吩中也被测量到^[23],他们把这些谐 振振荡归于在薄膜中相干声子的产生和传播,即剩 余的光子能量(即激发光光子能量(3.5 eV)和 PPV 吸收带底(约 2.4eV)间的能量差)产生热量,并通 过薄膜热膨胀产生平面应力波,即长程声学声 子^[24].因而这个应力波实质上是光-声相互作用,在 薄膜中激发出声脉冲且在膜的前后面反射,并调制 样品的吸收系数,这时,一个时间延迟的探测脉冲 借助于声脉冲对样品吸收系数的调制,可以探测到 长程声学声子在薄膜中的传播^[22].当激发脉冲的宽 度小于声子的振荡周期时,时间延迟的探测脉冲就 可以探测到声子的振荡周期.从图 3 还可以看到实 际的振荡周期是随延迟时间而缩短,一个固定的振 荡周期常数不能完全拟合实验数据.振荡的振幅也 是随延迟时间而减小,这是因为声波在薄膜与石英 玻璃交界处反射损失.声波的传播速度可由 v_s =



图 3 时间演化动力学曲线 (在 355 nm 激光脉冲激发下在 496 nm 处 PPV 与延迟时间相关的瞬态消光弛豫)

4d/τ^[22]获得,其中 d 是薄膜厚度,τ 是谐振振荡周期. PPV 的膜厚是 140 nm,由实验获得的谐振振荡 周期为 331 ps,则声速是 17 Å/ps,相应于 1.7 km/s. 这个声速与文献[23]的预期是一致的,即长程声子的声速一般为每皮秒几个纳米.

4. 结 论

利用时间分辨的激发-探测瞬态光谱技术,我们 研究和比较了导电高分子样品 PPV 在有无施加偏置 电场时激发态的弛豫特性.激子的弛豫表现为快慢两 个衰减过程:一个是超快的激子猝灭过程,是电场相 关的,由无电场时的 77 ps 减少到有偏置场时的 47 ps,施加的偏置场加速了激子的离解;而慢弛豫过程 是电场无关的,其时间常数约为 890 ps. 快慢组分的 权重显现了明显的电场相关,超快过程由无电场时 22% 的权重增加为有电场时的 72%.在消光光谱部分 我们还观测到了长程声学声子,其声速是 1.7 km/s.

- [1] Mezyk J, Meinardi F, Cocchi M 2008 Appl. Phys. Lett. 93 093301
- [2] Kalinowski J 2005 Organic Light Emitting Diodes: Principles, Characteristics, and Processes (New York: Marcel Dekker) p135
- [3] Stampor W, Mezyk J 2007 Chem. Phys. 337 151
- [4] Kalinowski J, Mezyk J, Meinardi F, Tubino R, Cocchi M, Virgili D 2005 J. Appl. Phys. 98 063532-1
- [5] Holzer W, Penzkofer A, Tsuboi T 2005 Chem. Phys. 308 93
- [6] Jiang H, Xu X H, Sun X, Fu R L, Chu J H 1999 Acta Phys.
 Sin. 48 2327 (in Chinese) [姜 浩、徐晓华、孙 鑫、傅柔 励、褚君浩 1999 物理学报 48 2327]
- [7] Arkhipov V I, Bässler H, Deussen M, Göbel E O, Kersting R, Kurz H, Lemmer U, Mahrt R F 1995 Phys. Rev. B 52 4932
- [8] Yang H, Zhang T Q, Wang S F, Gong Q H 2000 Acta Phys. Sin. 49 1292 (in Chinese) [杨 宏、张铁桥、王树峰、龚旗煌 2000 物理学报 49 1292]
- [9] Gadermaier C, Grasse F, Perissinotto S, Graf M, Galbrecht F, Scherf U, List E J W, Lanzani G 2008 Phys. Rev. Lett. 100 057401
- [10] Bässler H 1997 Primary Photoexcitations in Conjugated Polymers: Molecular Exciton Versus Semiconductor Band Model (Singapore: World Scientific) p51
- [11] Maniloff E S, Klimov V I, McBranch D W 1997 Phys. Rev. B 56 1876
- [12] Zaushitsyn Y, Gulbinas V, Zigmantas D, Zhang F L, Inganäs O, Sundström V, Zartsev A 2004 Phys. Rev. B 70 075202

- [13] Shkunov M N, Huang J D, Vardeny Z V, Yoshino K 1999 Synth. Metals 102 1118
- [14] Li A Z, Chen Z F, Wang H, Zhang Y W, Zhang W, Yu H C, Huang J W, Ji L N 2009 Acta Phys. Sin. 58 1321 (in Chinese)
 [黎爱珍、陈志峰、王 惠、张燕伟、张 伟、余汉诚、黄锦汪、 计亮年 2009 物理学报 58 1321]
- [15] Yin S H, Liu J Y, Lou N Q 2006 J. At. Mol. Phys. 23 49 (in Chinese) [尹淑慧、刘建勇、楼南泉 2006 原子与分子物理学报 23 49]
- [16] Samuel I D W, Crystal B, Rumbles G, Burn P L, Holmes A B, Friend R F 1993 Chem. Phys. Lett. 213 472
- [17] Yan M, Rothberg L J, Papadimitrankopoulos F, Galvin M E, Miller T M 1993 Phys. Rev. Lett. 73 2827
- [18] Heeger A J 1997 Primary Photoexcitations in Conjugated Polymers: Molecular Exciton Versus Semiconductor Band Model (Singapore: World Scientific) p20
- [19] McBranch D W, Sinclair M B 1997 Primary Photoexcitations in Conjugated Polymers: Molecular Exciton Versus Semiconductor Band Model (Singapore: World Scientific) p587
- [20] Kepler R G, Valencia V S, Jacobs S J, McNamara J J 1996 Synth. Metals 78 227
- [21] Zhao E H, Fu R T, Sun X, Fu R L, Zhu J H 1998 Acta Phys. Sin. 47 2031 (in Chinese) [赵二海、傅荣堂、孙 鑫、傅柔 励、褚君浩 1998 物理学报 47 2031]
- [22] Thomsen C, Strait J, Vardeny Z, Maris H J, Tauc J 1984 Phys. Rev. Lett. 53 989

[23] Kanner G S, Vardeny Z V, Hess B C 1990 Phys. Rev. B 42 5403

Effect of the electric field on the decay of excited states in poly-phenylenevinylene*

Cheng Ping Gao Feng Chen Xiang-Dong Yang Ji-Ping[†]

(School of Electronic Science and Applied Physics, Hefei University of Technology, Hefei 230009, China)

(Received 7 June 2009; revised manuscript received 12 August 2009)

Abstract

To gain an insight into the effect of electric field on the electro-luminescence of organic light emission diode, the ultrafast pump-probe spectroscopy is used to investigate the transient phenomena of the excitons induced by the electric field. Under the excitation density of $230 \ \mu J/cm^2$, the decay of the singlet excitons shows a fast and a slow component. The amplitude factor and the relaxation time of fast component are field-dependent. Compared with the zero biascase, the relaxation time of the fast component becomes faster at a bias of 6.4×10^5 V/cm, its amplitude factor is increased from 22% to 72%, about 50% initial excitons are dissociated by the electric field. The slow component is field-independent, its relaxation time-constant is about 890 ps. The longitudinal acoustic phonons with sound velocity of 17 Å/ps generated by excitation pulse are observed.

Keywords: poly-phenylenevinylene, ultrafast spectroscopy, exciton, organic light emission diode PACC: 7847, 7280L, 7280H

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 20573030).

[†] Corresponding author. E-mail:yangjp@hfut.edu.cn